

「ISSP ワークショップ 真空紫外アンジュレータビームラインの高度化と物性科学」

日時：2009年12月18日（金）10:00-17:00

場所：物性研究所6階大講義室

プログラム

（座長：柿崎明人）

- 10:00-10:20 はじめに — BL19 リポルバーアンジュレータビームラインの現状 —  
東大物性研 柿崎明人
- 10:20-10:40 BL19 分光光学系の更新  
東大物性研 藤沢正美
- 10:40-11:00 電磁石アンジュレータの可能性（仮題）  
KEK 物構研 山本 樹
- 11:00-11:20 UVSOR 低エネルギービームラインの現状（仮題）  
分子研 UVSOR 木村真一
- 11:20-11:40 HiSOR 低エネルギービームラインの現状（仮題）  
広大理 木村昭夫

11:40-13:00 昼 食

（座長：木村昭夫）

- 13:00-13:20 スピン分解光電子分光の新展開、COPHEE から ESPRESSO へ 広大 HiSOR 奥田太一
- 13:20-13:40 対称性に起因する特異な Rashba 効果  
千葉大工 坂本一之
- 13:40-14:00 Bi および Pb 吸着 Ge (111) 表面の Rashba 型スピン分裂  
京大理 八田振一郎
- 14:10-14:20 休 憩
- 14:20-14:40 Si 表面上 In 原子鎖への電子ドーピングの効果  
Yonsei 大学 守川春雲
- 14:40-15:00 半導体表面に形成した表面構造の歪による電子状態の変化  
横浜市大 重田諭吉
- 15:00-15:20 Au/Ge 表面の電子状態  
東大物性研 中辻 寛

15:20-15:30 休 憩

（座長：木村真一）

- 15:30-15:50 金属水素化物の電子状態研究  
筑波大物質 関場一男
- 15:50-16:10 チタン薄膜直下におけるシリコン酸化促進反応の解析  
横浜国大理 大野真也

（座長：吉信 淳）

- 16:10-17:00 「BL19 アンジュレータビームライン高度化に対するアンケート」の結果について  
東大物性研 松田 巖